

東芝トランジスタ シリコンPNPエピタキシャル形 (PCT方式)

2SA1298

- 低周波電力増幅用
- 電力スイッチング用

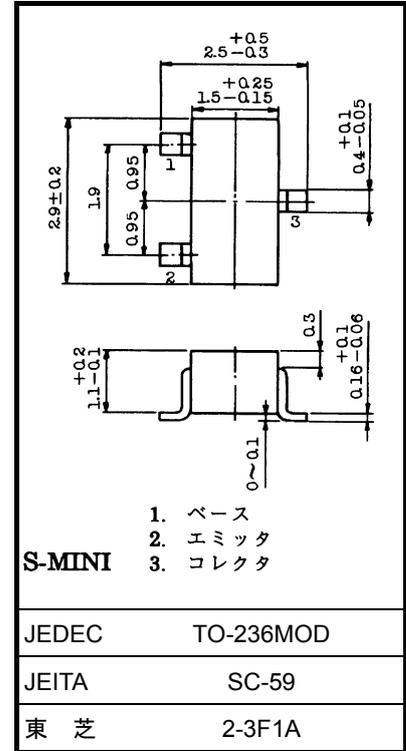
- 直流電流増幅率が高い。: $h_{FE} = 100 \sim 320$
- コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低い。
: $V_{CE(sat)} = -0.4 \text{ V (最大)}$ ($I_C = -500 \text{ mA}$, $I_B = -20 \text{ mA}$)
- 小型モータのドライブ用に適します。
- 2SC3265 とコンプリメンタリになります。

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-800	mA
ベース電流	I_B	-160	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~150	°C

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
 弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

単位: mm



質量: 0.012 g (標準)

製品量産開始時期
1982-10

電氣的特性 (Ta = 25°C)

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -30 V, I _E = 0	—	—	-0.1	μA
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5 V, I _C = 0	—	—	-0.1	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR) CEO}	I _C = -10 mA, I _B = 0	-25	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR) EBO}	I _E = -0.1 mA, I _C = 0	-5	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	h _{FE} (1) (注)	V _{CE} = -1 V, I _C = -100 mA	100	—	320	
	h _{FE} (2)	V _{CE} = -1 V, I _C = -800 mA	40	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE (sat)}	I _C = -500 mA, I _B = -20 mA	—	—	-0.4	V
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	V _{CE} = -1 V, I _C = -10 mA	-0.5	—	-0.8	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} = -5 V, I _C = -10 mA	—	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = -10 V, I _E = 0, f = 1 MHz	—	13	—	pF

注: h_{FE} (1) 分類 O: 100~200, Y: 160~320

現品表示

